

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ

(ダーリントン接続)

低周波電力増幅用

特 徴

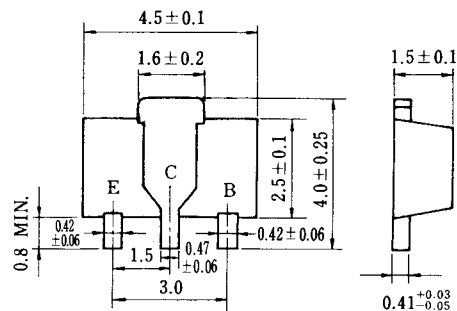
- 小形外形ながら、800 mAまでの高 h_{FE} ダイレクトドライブが可能です。(ダーリントン接続)
- 低 $V_{CE(sat)}$ です。

絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60 ± 10	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60 ± 10	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	8.0	V
コレクタ電流(直 流)	$I_{C(DC)}$	± 0.8	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}^*$	± 1.2	A
全 損 失	P_T^{**}	2.0	W
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

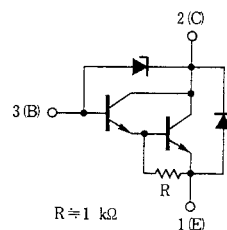
* $PW \leq 10 \text{ ms}$, Duty Cycle $\leq 50 \%$ ** $0.7 \text{ mm} \times 16 \text{ cm}^2$ セラミック基板使用時

外形図 (単位: mm)



電極接続

E: Emitter
C: Collector (Fin)
B: Base

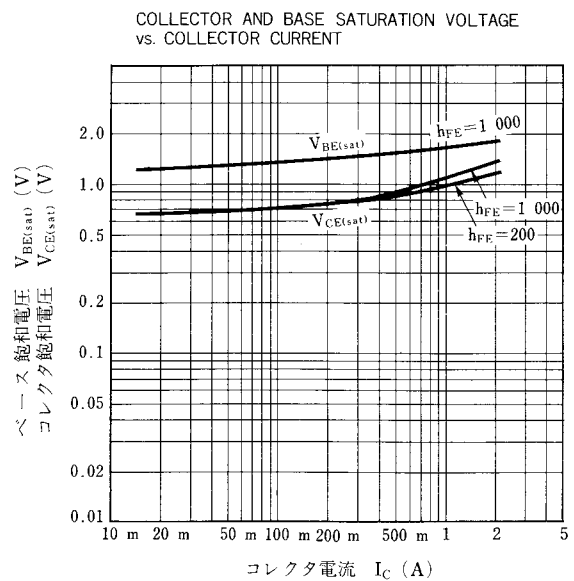
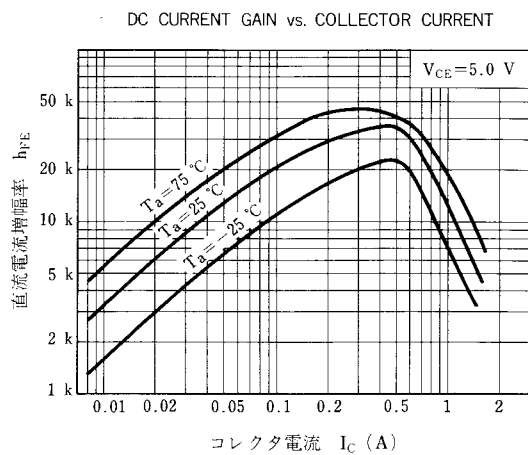
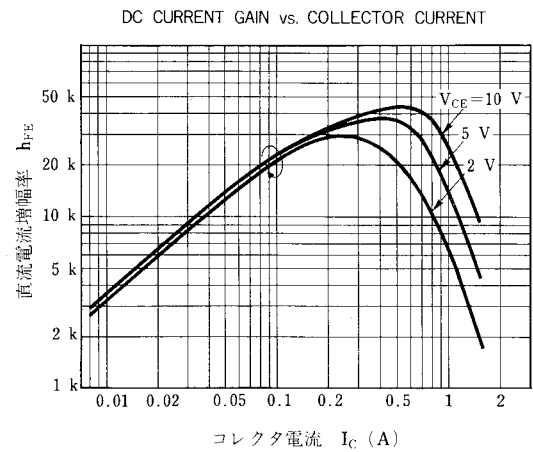
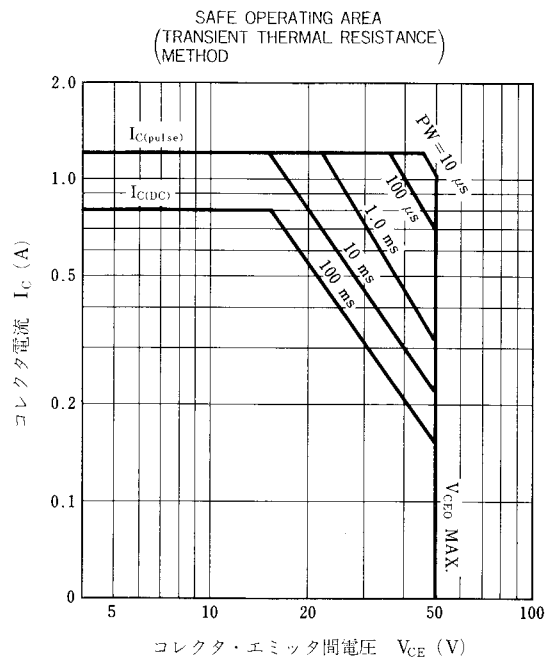
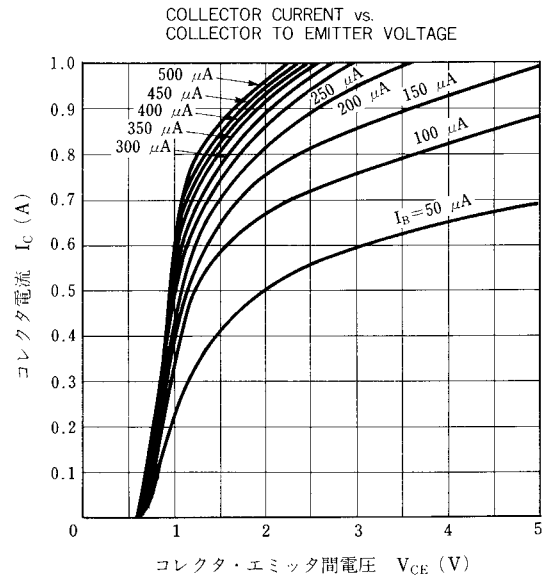
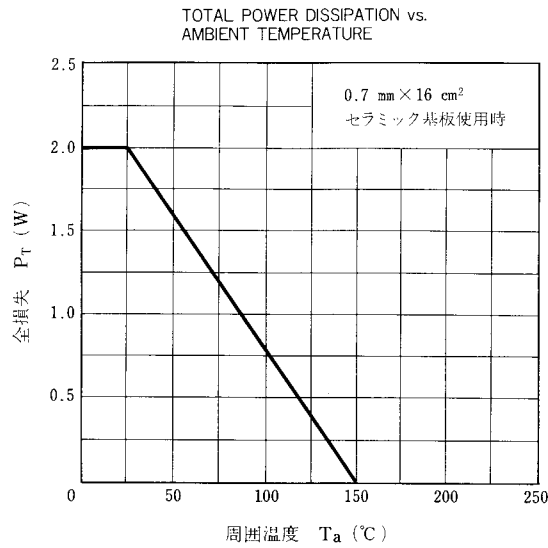
電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	$I_C=0.1 \text{ mA}$, $I_E=0$	50	60	70	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	$I_C=5.0 \text{ mA}$, $I_B=0$	50	60	70	V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=40 \text{ V}$, $I_E=0$			1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0 \text{ V}$, $I_C=0$			1.0	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE1}^{***}	$V_{CE}=2.0 \text{ V}$, $I_C=0.5 \text{ A}$	4 000		50 000	
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE2}^{***}	$V_{CE}=2.0 \text{ V}$, $I_C=0.8 \text{ A}$	1 000			
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}^{***}$	$I_C=0.5 \text{ A}$, $I_B=1.0 \text{ mA}$		0.9	1.2	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}^{***}$	$I_C=0.5 \text{ A}$, $I_B=1.0 \text{ mA}$		1.5	2.0	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=0.5 \text{ A}$ $I_{B1}=-I_{B2}=1.0 \text{ mA}$ $V_{CC}=40 \text{ V}$, $R_L=80 \Omega$		0.5		μs
蓄 積 時 間	t_{stg}			2.5		μs
下 降 時 間	t_f			1.0		μs

***パルス測定 $PW \leq 350 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2 \%$ h_{FE} 規格区分

捺 印	TF	TE
h_{FE1}	4 000~12 000	8 000~50 000

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)



参考資料

資 料 名	資 料 番 号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージ・マニュアル	IEI-635
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
半導体総合セクション・ガイド	MF-212
パルス電力損失時におけるトランジスタの 接合部温度の算出方法について	TEB-528
トランジスタの E-B 接合ブレイクダウンによる h _{FE} , ノイズ劣化	TEB-537

〔メモ〕

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- この製品を使用したことにより、第三者の工業所有権等にかかわる問題が発生した場合、当社製品の構造製法に直接かかわるもの以外につきましては、当社はその責を負いませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.6

— お問い合わせは、最寄りの NEC へ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2755
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208
北海道支社 東北支社 岩手支店 山形支店 郡山支店 いわき支店 長岡支店 土浦支店 水戸支店 神奈川支店 群馬支店 太田支店 宇都宮支店	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)261-5511 盛岡 (0196)51-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (0292)26-1717 横浜 (045)324-5511 高崎 (0273)26-1255 太田 (0276)46-4011 宇都宮 (0286)21-2281	富山支店 (0764)31-8461 山重支店 (0592)25-7341 京都支社 (075)344-7824 神戸支社 (078)332-3311 中国支社 (082)242-5504 鳥取支店 (0857)27-5311 岡山支店 (086)225-4455 四国支店 (0878)36-1200 新居浜支店 (0897)32-5001 松山支店 (0899)45-4111 九州支社 (092)271-7700 北九州支店 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区栄四丁目14番5号 (松下中日ビル)	名古屋 (052)242-2762	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	

C94.7